

*課題番号 : F-12-TU-0080
*支援課題名 (日本語) : シリコンウエハの酸化
*Program Title (in English) : Thermal oxidation of Si wafer
*利用者名 (日本語) : 矢作徹
*Username (in English) : Toru Yahagi
*所属名 (日本語) : 山形県工業技術センター
*Affiliation (in English) : Yamagata Research Institute of Technology

※研究概要 (Summary) :

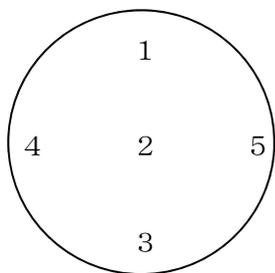
500 μm 厚さの 4 インチ Si ウエハ 40 枚に 1 μm 厚さの熱酸化膜を形成する。

※実験 (Experimental) :

酸化炉 (MEMS 用) に 500 μm 厚さの 4 インチ Si ウエハ 40 枚をセットし 1100°C で 3.5 時間加熱した。

※結果と考察 (Results and Discussion) :

酸化後に 1 枚のウエハについて形成された熱酸化膜の厚さを測定したところ、平均で 1.02 μm の熱酸化膜が形成されていた。これらはほぼ期待どおりの膜厚である。



測定点	膜厚 (\AA)
1	10216
2	10182
3	10216
4	10192
5	10197
平均	10200

※その他・特記事項 (Others) :

なし